MAGNETIC RECORDING MEDIUM

Patent Number:

JP6028655

Publication date:

1994-02-04

Inventor(s):

KANEKO HIDEO; others: 02

Applicant(s):

SHIN ETSU CHEM CO LTD

Requested Patent:

JP6028655

Application Number: JP19930073707 19930331

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B5/66

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To provide a magnetic recording medium excellent in floating characteristics by forming a substrate of a nonmagnetic material with single crystalline silicon and imparting <111> crystal orientation to the crystal orientation of the single crystalline silicon perpendicular to one side of the substrate on which a magnetic recording layer is formed.

CONSTITUTION: When a magnetic recording layer of a magnetic material is formed on at least one side of a flat substrate of a nonmagnetic material to obtain a magnetic recording medium, the substrate is formed with single crystalline silicon and <111> crystal orientation is imparted to the crystal orientation of the single crystalline silicon perpendicular to the side of the substrate on which the magnetic recording layer is formed. The substrate of the single crystalline silicon has high Vickers hardness and warps hardly at the time of heat treatment and film formation can be carried out at 600 deg.C or higher. By the <111> crystal orientation, floating characteristics can be improved and coercive force can be increased.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

Japanese Patent Provisional Publication No. 6-28655

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-28655

(43)公開日 平成6年(1994)2月4日

(51)Int.Cl.⁵

識別配号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G11B 5/66

7303-5D

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平5-73707

(22)出願日

平成5年(1993)3月31日

(31)優先権主張番号 特願平4-112164

(32)優先日

平4(1992)4月3日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000002060

信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

(72)発明者 金子 英雄

神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号

信越化学工業株式会社コーポレートリサ

ーチセンター内

(72)発明者 徳永 勝志

神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号

信越化学工業株式会社コーポレートリサ

ーチセンター内

(74)代理人 弁理士 山本 亮一 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称 】 磁気記録媒体

(57)【要約】

(修正有)

【目的】本発明は、硬度が高くてそりが小さく、高温で 成膜することができ、保磁力を大きくするための加熱パ ワーが小さくてすみ、かつ<u>CSS</u>特性がよい磁気記録媒 体の提供を目的とするものである。

【構成】平板状の非磁性材料からなる基板と、その少な くとも片面に形成された磁性材料からなる磁気記録層と からなる磁気記録媒体において、該非磁性材料からなる 基板が単結晶シリコンであり、かつ基板の録層を形成す る面と<u>垂直</u>をなす単結晶シリコンの結晶方位が<111 >であることを特徴とするものである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 平板状の非磁性材料からなる基板と、その 少なくとも片面に形成された磁性材料からなる磁気記録 層とからなる磁気記録媒体において、該非磁性材料から なる基板が単結晶シリコンであり、かつ基板の磁気記録 層を形成する面と垂直をなす単結晶シリコンの結晶方位 が<111>であることを特徴とする磁気記録媒体。

1

【請求項2】磁気記録層を形成する面に対し垂直方向と 単結晶シリコンの結晶方位<1111>とのなす角度が1 5°以下である請求項1に記載の磁気記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は磁気記録媒体、特には髙 密度記録のできる基板からなる磁気記録媒体に関するも のである。

[0002]

【従来の技術】情報化社会の進展に伴なって大容量の記 録媒体が必要とされ、特にコンピューターの外部メモリ として中心的役割を果たしている磁気ディスクについて は年々記録容量、記録密度が増加してきているが、さら に高密度の記録を行なうために開発が進められている。 特にノート型パソコンやパームトップパソコンの開発に よりさらに高密度記録のできるものが望まれている。

【0003】このような磁気ディスクにおける記録媒体 の強度、表面の平滑度、そり、重量などの機械特性は基 板によるものとされており、この磁気ディスク用の基板 としては従来からアルミニウム合金が用いられている が、これについては記録密度の向上に伴なってより表面 粗さが小さく、かつ、耐摩耗性の大きいものが求められ ており、特にノート型パソコンの普及に伴なって消費電 30 力が少なくてすむ磁気ディスクが求められているが、磁 気ディスクドライブの電力消費の多くはスピンドルモー ターによるものであるから電力消費を少なくするために 軽量な基板が求められている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】他方、髙記録密度のた めには記録膜は保磁力の大きい方が望ましいのである が、一般に用いられているコバルト合金ではある温度ま では成膜温度の高いほど保磁力は大きくなり、この保磁 力を大きくする目的で成膜前にその基板を加熱するので あるが、アルミニウム合金は柔らかいものであるために 耐摩耗性、加工性が悪く、これを補なうためにその表面 に NiPメッキを行なうことが一般に行なわれているが、 この NiP膜とアルミニウム合金との熱膨張率の差のため に、加熱、冷却時に基板がそり易くなるし、NiP 膜は 2 80℃以上に加熱すると磁性を帯びるためにあまり高温で 成膜することができないという不利がある。

【0005】また、この磁気ディスク用基板については 硬く、表面粗さが小さいということからガラス基板も用 いられているが、このガラス基板は強化処理してあるた 50

めに表面にひずみ層があり、圧縮応力が働いていること から基板を加熱すると基板がそり易いという欠点がある し、このものは加熱がしにくいために十分な保磁力を得 るには大きな加熱パワーが必要とされるという欠点もあ る。なお、従来から用いられている磁気ディスク装置は 通電前は情報の書き込み、読みとりに用いられる磁気へ ッドが磁気ディスクに接触しており、通電し、磁気ディ スクが回転すると風圧で磁気ヘッドが磁気ディスクから 浮上する方式(CSS方式)を用いているために、磁気 ディスクが静止している状態が続くと磁気ヘッドと磁気 ディスクが吸着してしまい、スピンドルモーターに過負 荷がかかったり、記録膜が傷ついたりして情報が読み出 せなくなることがある。

2

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明はこのような不 利、欠点を解決した磁気記録媒体に関するもので、これ は平板状の非磁性材料からなる基板と、その少なくとも 片面形成された磁性材料からなる磁気記録層とからなる 磁気記録媒体において、該非磁性材料からなる基板が単 結晶シリコンであり、かつ基板の磁気記録層を形成する 面と垂直をなす単結晶シリコンの結晶方位が<111> であることを特徴とするものである。すなわち、本発明 者らは上記したような不利、欠点を伴なわない磁気記録 媒体を開発すべく種々検討した結果、この基板を単結晶 シリコンとしたところ、このものはビッカース硬度が高 く、熱処理したときのそりも小さく、 600℃以上で成膜 することができ、しかも比重も 2.3と軽く、強度も十分 で、小さい加熱パワーで大きな保磁力を得ることがで き、この面方位を<111>にすることによりCSS特 性の向上をはかることができることを見出し、さらにこ の磁気記録層を形成する面に対し垂直方向と単結晶シリ コンの結晶方位<1111>とのなす角度が15。以下と すればよいということを確認して本発明を完成させた。 以下にこれをさらに詳述する。

[0007]

【作用】本発明は磁気記録媒体に関するものであり、こ れは平板状の非磁性材料から基板と、その少なくとも片 面に形成された磁性材料なる磁気記録層とからなる磁気 記録媒体において、該非磁性材料からなる基板が単結晶 シリコンであり、かつ磁気記録層を形成する面と垂直を なす結晶方位が<111>であることを特徴とするもの であるが、磁気記録媒体の基板を単結晶シリコンからな るものとすると、この単結晶シリコンが軽量で硬度の高 いもので熱処理でのそりが小さく、このものは 600℃以 上でも成膜できるし、小さい加熱パワーで大きな保磁力 を得ることができるという有利性をもつものであるの で、髙密度記録のできる磁気記録媒体を得ることができ る。

【0008】本発明の磁気記録媒体はその基板を単結晶 シリコンからなるものとしたものであるが、この単結晶

シリコンは比重が 2.3でA1合金の 2.7より小さい軽いものであることから磁気ディスクドライブ用の電力消費の少ないものとなるし、この単結晶シリコンはビッカース硬度が 1,000で従来から用いられている NiP膜のついた A1-Mn合金のビッカース硬度 500に比べて硬度の高いものであるために、特別な硬化層を必要とせず、したがってこの単結晶シリコンから作られた基板には加熱時にそりの発生が小さいという有利性が与えられる。

【0009】また、この基板を NiP膜のついたAl合金とするとこれが280 ℃以上では NiP膜が磁性を帯びてしま 10 い、成膜温度をこれ以上にすることができないのであるが、これを単結晶シリコンとすると相転移などは 1,410 ℃の融点までないために、600 ℃以上の高い温度で成膜することができる。

【0010】また、基板を単結晶シリコンとすると、保 磁力を大きくするための成膜時の加熱パワーを小さくす ることができ、例えばこの保磁力を1,300 Oeとするのに ガラス基板では 3.8KWの加熱パワーが必要とされるの であるが、単結晶シリコンとすれば 2.4KWですむとい う有利性も与えられる。また、ガラス基板を用いると磁 20 気ディスク面内における磁気記録膜の保磁力のバラツキ は大きいが、単結晶シリコンを用いることによって保磁 力のバラツキが小さくなるという有利性も与えられる。 硬度等の特徴だけならば、磁気ディスク基板は多結晶シ リコンとしてもよいのであるが、多結晶シリコンは強度 が単結晶シリコンに比べて小さいという欠点がある。特 開昭57-105826号は磁気ディスク基板としてシ リコンを用いる構造を開示しているが、単結晶シリコン を用いることでこのような強化コア部材を必要としな い。また、特公平2-41089号にはシリコンを基板 30 として用いる時の膜構成が述べられているが、ここでは 基板の強度やCSS特性については何も考慮されていな い。

【0011】本発明による磁気記録媒体のさらなる特徴は、単結晶シリコン基板の磁気記録膜を形成する面と垂直をなす結晶方位が<111>であることであるが、特にこれを<111>からのずれを15°以下とすることで実施例で示されているように磁気ディスクと磁気ヘッドの吸着が小さくなり、したがってCCS特性もよくなるという有利性が与えられる。なお、本発明による磁気 40記録媒体に用いられる単結晶シリコンは特公平2-41089にある「半導体市場で用いられている」ものである必要はない。例えば、太陽電池用に用いられている結晶の方が廉価で好ましい。

[0012]

【実施例】つぎに本発明の実施例をあげる。

実施例1

単結晶シリコンと多結晶シリコンとを幅10mm、厚さ2mm、長さ30mmに加工し、これらについて3点曲げ強度の 測定を連続荷重で行なったところ、第1図に示したとお 50 りの結果が得られ、単結晶シリコンのほうが多結晶シリコンに比べて強度の大きいものであることが確認された。

【0013】実施例2、比較例1

直径95mnの単結晶シリコン基板上および比較例としてのガラス基板上に、Crを100nm、Cose C12 Ta2を60nm、Cを30nmの順に赤外線ヒーターで加熱したのち、DCスパッタリング法で成膜した。ついで、これらを赤外線ヒーターの加熱パワーと保磁力の関係を調べたところ、図2のようになった。図2より保磁力が1,300 0eになるところで比較すると、ガラス基板では3.8KWの加熱パワーが必要とされたが、単結晶シリコン基板での加熱パワーは2.4KWですむことが確認された。

【0014】実施例3

種々の面方位をもつディスク基板を作成したのち、実施例2と同様に成膜し、潤滑剤を塗布したのち、磁気へッドと磁気ディスクを接触させたまま温度60℃、湿度90%で1晚放置し、磁気ディスク回転初期の磁気ディスクと磁気ヘッドの吸着力(μ)を測定したところ、図3に示したとおりの結果が得られた。

[0015]

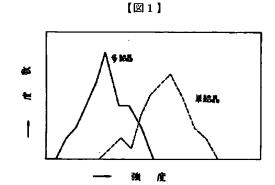
【発明の効果】本発明は磁気記録媒体に関するものであ り、これは前記したように平板状の非磁性材料から基板 と、その少なくとも片面に形成された磁性材料なる磁気 記録層とからなる磁気記録媒体において、該非磁性材料 からなる基板が単結晶シリコンであり、かつ基板の磁気 記録層を形成する面と垂直をなす単結晶シリコンの結晶 方位が<111>であることを特徴とするものである が、これによれば単結晶シリコンがAl合金に比べて軽量 で硬度が高く、熱処理によるそりも小さく、さらには 6 00℃以上での成膜もでき、さらにはガラス基板よりも小 さいパワーで加熱することができるので、従来より用い られているAl合金を基板とするものに比べて、高温で成 膜することができ、しかも保磁力を大きくするための加 熱も小さい加熱パワーで容易に上昇させることができる という有利性が与えられ、さらに基板の磁気記録膜を形 成する面と垂直をなす結晶方位を<111>とすると、 CSS特性の優れたものにすることができるという有利 性が与えられる。

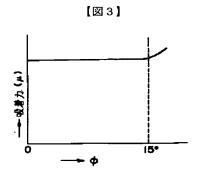
【図面の簡単な説明】

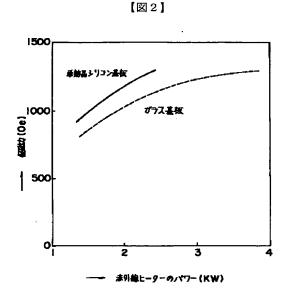
【図1】 単結晶シリコンと多結晶シリコンの強度と度数との相関関係図を示したものである。

【図2】 成膜を行なった単結晶シリコン基板とガラス 基板との赤外線ヒーターの加熱パワーと保磁力との関係 における比較図を示したものである。

【図3】 実施例3で作られた種々の面方位をもつディスク基板における磁気記録層を形成する面に対し垂直方向と単結晶シリコンの結晶方位<111>とのなす角(φ)とディスク回転初期の磁気ディスクと磁気ヘッドとの吸着力(μ)との関係図を示したものである。







【手続補正書】

【提出日】平成5年5月25日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正内容】

[0007]

【作用】本発明は磁気記録媒体に関するものであり、これは平板状の非磁性材料から<u>なる</u>基板と、その少なくとも片面に形成された磁性材料<u>から</u>なる磁気記録層とからなる磁気記録媒体において、該非磁性材料からなる基板が単結晶シリコンであり、かつ磁気記録層を形成する面と垂直をなす結晶方位が<111>であることを特徴とするものであるが、磁気記録媒体の基板を単結晶シリコンが軽量で硬度の高いもので熱処理でのそりが小さく、このものは600 ℃以上でも成膜できるし、小さい加熱パワーで大きな保磁力を得ることができるという有利性を持つものであるので、高密度記録のできる磁気記録媒体を得ることができる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

【0011】本発明による磁気記録媒体のさらなる特徴は、単結晶シリコン基板の磁気記録膜を形成する面と垂直をなす結晶方位が<111>であることであるが、特にこれを<111>からのずれを15°以下とすることで実施例で示されているように磁気ディスクと磁気へッドの吸着が小さくなり、したがってCSS特性もよくなるという有利性が与えられる。なお、本発明による磁気記録媒体に用いられる単結晶シリコンは特公平2-41089にある「半導体市場で用いられている」ものである必要はない。例えば、太陽電池用に用いられている結晶の方が廉価で好ましい。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】実施例2、比較例1

直径 9.5 mmの単結晶シリコン基板上および比較例としてのガラス基板上に、 $C_{\underline{r}}$ を100 nm、 $C_{0.86}$ $C_{\underline{r}}$ 12 $T_{0.12}$ T_{0

を赤外線ヒーターの加熱パワーと保磁力の関係を調べたところ、図2のようになった。図2より保磁力が1,3000になるところで比較すると、ガラス基板では3.8 KWの加熱パワーが必要とされたが、単結晶シリコン基板での加熱パワーは2.4 KWですむことが確認された。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0015

【補正方法】変更

【補正内容】

[0015]

【発明の効果】本発明は磁気記録媒体に関するものであり、これは前記したように平板状の非磁性材料からなる 基板と、その少なくとも片面に形成された磁性材料<u>から</u>なる磁気記録層とからなる磁気記録媒体において、該非

フロントページの続き

(72)発明者 俵好夫

神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 信越化学工業株式会社コーポレートリサ ーチセンター内 磁性材料からなる基板が単結晶シリコンであり、かつ基板の磁気記録層を形成する面と垂直をなす単結晶シリコンの結晶方位が<111>であることを特徴とするものであるが、これによれば単結晶シリコンがA1合金に比べて軽量で硬度が高く、熱処理によるそりも小さく、さらには600 ℃以上での成膜もでき、さらにはガラス基板とりも小さいパワーで加熱することができるので、で、なり、カーでのができ、しかも保磁力を大きくするための加熱も小さいがあるよりできるとするものに比べて、高温で成膜することができ、しかも保磁力を大きくするための加熱も小さい加熱パワーで容易に上昇させることができるという有利性が与えられ、さらに基板の磁気記録膜を形成する面と垂直をなす結晶方位を<111>とすると、CSS特性の優れたものにすることができるという有利性が与えられる。